

Capitolo 1

Estrazione dei parametri statici

In questo capitolo si tratteranno i parametri statici di transistori *MOS* in tecnologia *28nm* per comprendere come variano le prestazioni statiche all'aumentare dell'irraggiamento subito. Si tratteranno:

- Tensione di soglia

Aggiungere i
parametri statici
che studieremo

1.1 Tensione di soglia

La tensione di soglia V_{th} di un transistor MOS è definita come quella tensione tra gate e bulk per la quale la popolazione di minoritari all'interfaccia è uguale alla popolazione di maggioritari nel bulk. Questa definizione non può essere usata direttamente per il calcolo della tensione di soglia dei dispositivi, ma si deve passare attraverso l'analisi delle caratteristiche corrente-tensione dei dispositivi.

Per l'estrazione del parametro V_{th} esistono numerosi metodi[1], la scelta è solitamente dettata da un compromesso che si deve trovare fra complessità della procedura di estrazione della soglia e risultato ottenuto per la specifica applicazione. Per questo studio sono stati presi in considerazione:

- *Transconductance Change Method (TCM)*;
- *Second Difference of the Logarithm of the drain current Minimum method (SDLM)*;
- *Extrapolation in the Linear Region method (ELR)*;
- *Ratio Method (RM)*.

Per il nostro studio, però, non si è solo interessati al valore in sé della tensione di soglia dei dispositivi, ma anche a come questa varia all'aumentare dell'irraggiamento. Dunque, per ogni metodo non ci si ferma all'estrazione della V_{th} dei dispositivi non irraggiati, ma la si estrae anche dopo ogni step d'irraggiamento e, per ciascuno di questi, si calcola la $\Delta V_{th} = V_{th,Irraggiato} - V_{th,nonIrraggiato}$. La scelta di quale metodo usare per le analisi successive viene presa sulla qualità del parametro ΔV_{th} .

1.1.1 Transconductance Change Method

Il *Transconductance Change Method*, *TCM*, defisce la tensione di soglia come la tensione di gate-source V_{GS} corrispondente al picco massimo della derivata della transconduttanza g_m rispetto alla tensione di gate ($\frac{dg_m}{dV_{GS}}$) ed è valido per bassi valori della tensione V_{DS} .

Questa definizione si basa sul fatto che, quando il dispositivo passa dalla regione di debole inversione alla regione di forte inversione, la dipendenza della corrente di drain rispetto a V_{GS} passa dall'essere esponenziale all'essere lineare. La transconduttanza è definita come la derivata prima della corrente I_D rispetto alla tensione V_{GS} , dunque la derivata della g_m corrisponde alla derivata seconda di I_D . Per questo motivo, il massimo di $\frac{dg_m}{dV_{GS}}$ coincide con la tensione alla quale il grafico della corrente passa dalla forma esponenziale a quella lineare. Se V_{DS} è piccola, la tensione per la quale la g_m è massima è molto simile a V_{th} .

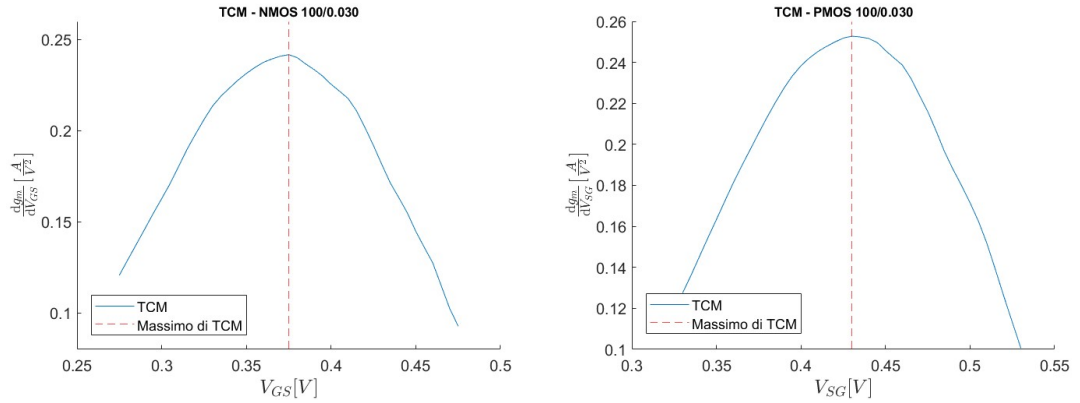


Figura 1.1: Esempio di *TCM* usato su un dispositivo NMOS e un dispositivo PMOS di dimensioni 100-0.030 a $V_{DS} = 150mV$

Per calcolare il *TCM* si deve trovare il massimo di una funzione, ovvero calcolarne la derivata prima. In questo caso si tratta in realtà di una derivata seconda, essendo già g_m calcolato con una derivata. Il calcolo della derivata non è effettuato su una funzione continua ma su dati misurati con uno step di 5mV di V_{gs} . Questo fa sì che la derivata prima e in modo maggiore la derivata seconda, siano affette da vere e proprie variazioni repentine dovuto alla natura granulare dei dati e non da fenomeni fisici. È quindi necessario rendere la funzione studiata meno dipendente da questo effetto. Inoltre, come detto in precedenza, la risoluzione con la quale sono state fatte le misure della corrente di drain è 5mV (di V_{gs}). Pertanto, con questo metodo si estrarrebbe una soglia che avrebbe una risoluzione di 5mV, del tutto inaccettabile in quanto sarebbe maggiore delle variazioni di soglia che potrebbero essere indotte dall'irraggiamento. Per far fronte a questi due problemi, si è scelto di non tenere conto del massimo direttamente ottenuto dallo studio di $\frac{dg_m}{dV_{GS}}$ ottenuto dai valori delle misure, ma d'interpolare prima i punti del grafico con una funzione polinomiale e, di ricavare il valore di soglia da questa funzione.

1.1 Tensione di soglia

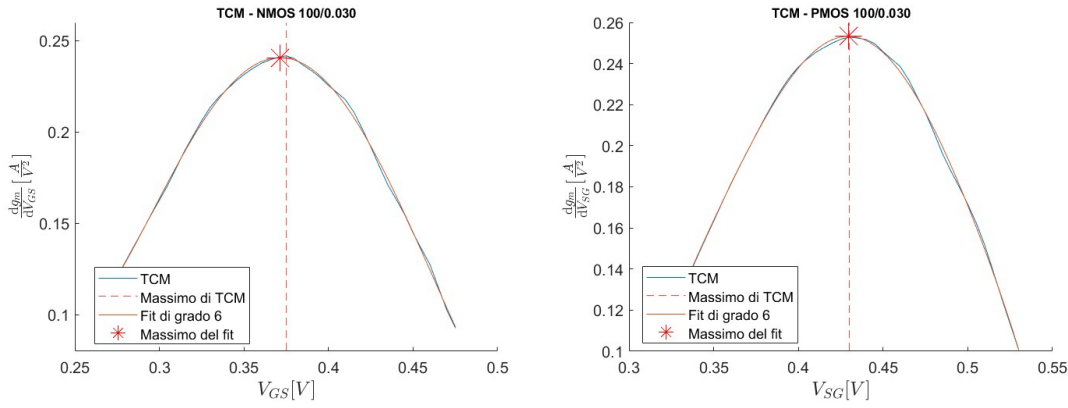


Figura 1.2: Esempio di *TCM* con fit polinomiale usato su un dispositivo NMOS e un dispositivo PMOS di dimensioni 100-0.030 a $V_{DS} = 150mV$

Lo studio del fit polinomiale risolve il problema della bassa risoluzione di misura, ma presenta una potenziale nuovo problema: il valore della V_{th} calcolata potrebbe variare significativamente al variare del grado della funzione polinomiale interpolante. Per capire l'effetto del grado della funzione interpolante sul valore di tensione di soglia estratto, si sono effettuate le estrazioni considerando i gradi 2, 4, 6 e 8 e si sono studiati i risultati ottenuti. Lo studio si è effettuato su dispositivi PMOS. Una volta scelto il valore del grado della funzione, lo stesso grado sarà utilizzato anche per l'estrazione della tensione di soglia degli NMOS.

Dispositivo	$V_{th}[mV]$ con interpolante di grado:			
	2	4	6	8
100 - 0.030	426.9	429.4	429.4	430.8
100 - 0.060	467.6	469.5	469.3	468.9
200 - 0.030	397.8	399.7	399.3	399.8
200 - 0.060	452.2	454.1	453.5	453.5
200 - 0.0180	495.6	495.6	495.3	495.5
600 - 0.030	383.0	387.4	385.9	386.2
600 - 0.060	431.1	434.3	434.7	435.6
600 - 0.0180	478.5	480.8	480.6	480.0

Tabella 1.1: Confronto dei valori di V_{th} dei dispositivi PMOS ottenuti con *TCM* con fit polinomiale di diversi gradi

Osservando i valori nella tabella 1.1, si può notare che la tensione di soglia ottenuta non varia molto nel caso dei fit fatti con polinomiali di grado 4, 6 e 8: è raro che la

differenza tra questi valori superiori $1mV$. Non si può dire la stessa cosa per le V_{th} calcolate con fit di grado 2: in questo caso la funzione interpolante ha un grado troppo basso per seguire in modo coerente la curva $\frac{dg_m}{dV_{GS}}$ e quindi il massimo risulta essere sia molto diverso da quelli calcolati con fit di grado maggiore. Dunque, al fine di fittare al meglio la curva, si è scelto un fit polinomiale di grado 6. In Tabella 1.2 e 1.3 sono ripostati i risultati ottenuti con il metodo *TCM* e fit polinomiale di grado 6 su dispositivi PMOS e NMOS pre e post irraggiamento. Nelle tabelle 1.4 e 1.5 e nei grafici a figura 1.3 vengono riportati i valori della ΔV_{th} .

Dispositivo	$V_{th}[mV]$						
	pre	5Mrad	50Mrad	100Mrad	200Mrad	600Mrad	1Grad
100 - 0.030	371.3	370.6	361.0	380.6	378.7	375.1	371.1
100 - 0.060	405.0	399.9	390.0	419.8	418.8	414.0	412.8
100 - 0.0180	476.0	472.4	459.5	491.9	491.2	492.0	491.1
200 - 0.030	359.5	357.9	348.1	369.2	367.0	363.8	361.7
200 - 0.060	402.2	398.3	385.0	415.5	413.7	412.3	411.0
200 - 0.0180	466.4	463.5	451.8	484.6	483.8	486.5	487.0
600 - 0.060	370.2	364.4	359.3	379.5	381.0	378.1	377.2
600 - 0.0180	449.6	447.9	430.7	458.8	458.4	458.9	458.4

Tabella 1.2: V_{th} dei dispositivi NMOS estratte con *TCM*

Dispositivo	$V_{th}[mV]$						
	pre	5Mrad	50Mrad	100Mrad	200Mrad	600Mrad	1Grad
100 - 0.030	429.4	430.7	432.2	434.4	439.0	452.6	459.4
100 - 0.060	469.3	469.6	471.4	472.7	479.7	491.8	500.8
200 - 0.030	399.3	401.0	403.1	404.8	410.2	422.3	429.8
200 - 0.060	453.5	455.2	456.2	458.6	463.8	476.9	485.8
200 - 0.0180	495.3	497.1	503.9	506.5	511.3	524.1	535.3
600 - 0.030	385.9	386.6	388.8	391.0	394.5	405.5	412.3
600 - 0.060	434.7	435.4	438.5	438.9	445.6	458.4	467.8
600 - 0.0180	480.6	481.5	483.7	486.0	492.0	507.2	519.6

Tabella 1.3: V_{th} dei dispositivi PMOS estratte con *TCM*

Dispositivo	$\Delta V_{th}[mV]$					
	<i>5Mrad</i>	<i>50Mrad</i>	<i>100Mrad</i>	<i>200Mrad</i>	<i>600Mrad</i>	<i>1Grad</i>
100 - 0.030	-0.7	-10.3	9.3	7.4	3.8	-0.2
100 - 0.060	-5.1	-15.0	14.8	13.8	9.0	7.8
100 - 0.0180	-3.6	-16.5	15.9	15.2	16.0	15.1
200 - 0.030	-1.6	-11.4	9.7	7.5	4.3	2.2
200 - 0.060	-3.9	-17.2	13.3	11.5	10.1	8.8
200 -180	-2.9	-14.6	18.2	17.4	20.1	20.6
600 - 0.060	-5.8	-10.9	9.3	10.8	7.9	7.0
600 - 0.0180	-1.7	-18.9	9.2	8.8	9.3	8.8

Tabella 1.4: ΔV_{th} dei dispositivi NMOS estratte con *TCM*

Dispositivo	$\Delta V_{th}[mV]$					
	<i>5Mrad</i>	<i>50Mrad</i>	<i>100Mrad</i>	<i>200Mrad</i>	<i>600Mrad</i>	<i>1Grad</i>
100 - 0.030	1.3	2.8	5.0	9.6	23.2	30.0
100 - 0.060	0.3	2.1	3.4	10.4	22.5	31.5
200 - 0.030	1.7	3.8	5.5	10.9	23.0	30.5
200 - 0.060	1.7	2.7	5.1	10.3	23.4	32.3
200 - 0.0180	1.8	8.6	11.2	16.0	28.8	40.0
600 - 0.030	0.7	2.9	5.1	8.6	19.6	26.4
600 - 0.060	0.7	3.8	4.2	10.9	23.7	33.1
600 - 0.0180	0.9	3.1	5.4	11.4	26.6	39.0

Tabella 1.5: ΔV_{th} dei dispositivi PMOS estratte con *TCM*

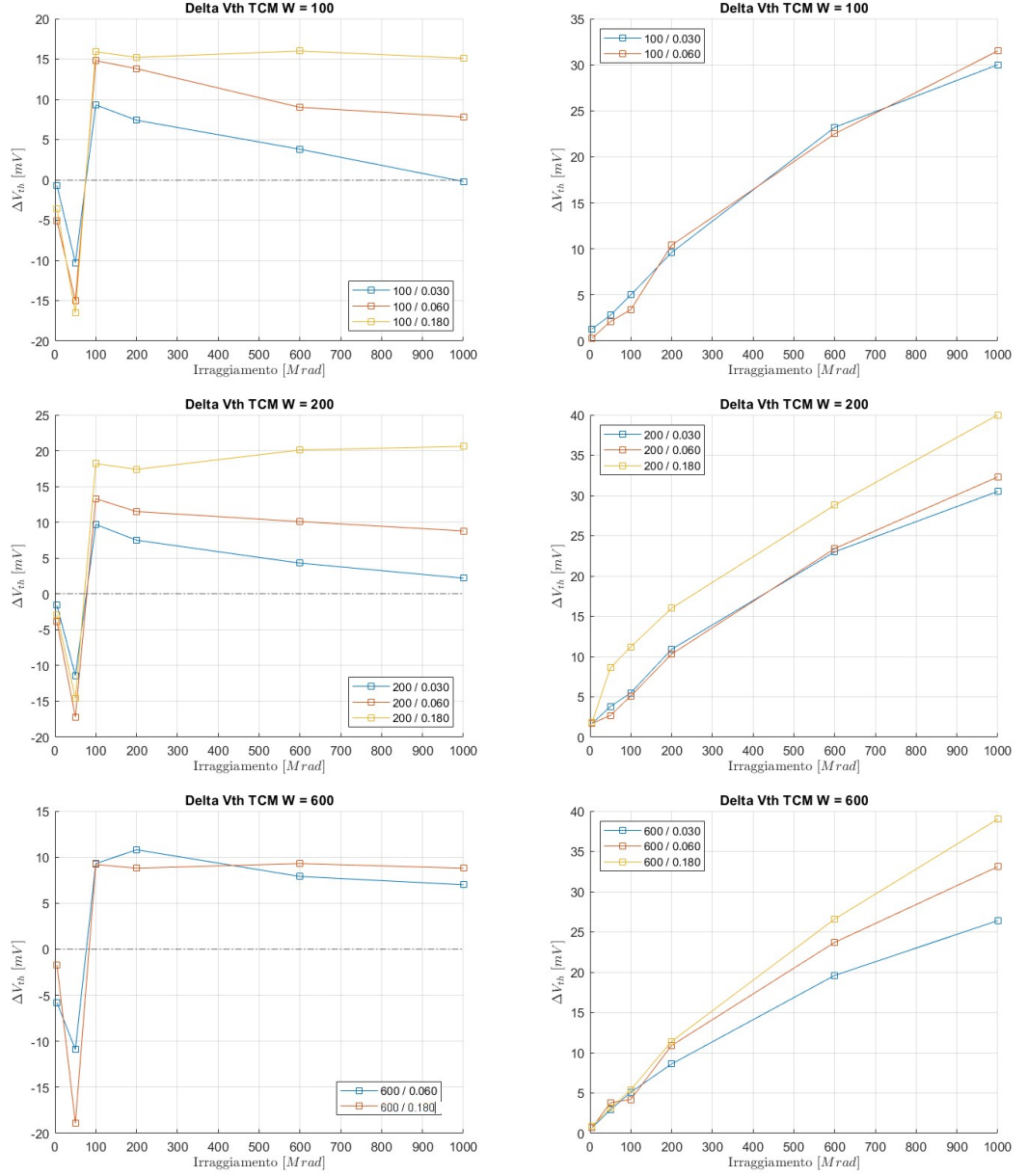


Figura 1.3: Variazioni di V_{th} dei dispositivi NMOS (a sinistra) e PMOS (a destra) estratte con TCM in funzione della dose assorbita. Ogni figura si riferisce a una larghezza di canale W differente. Raggruppate per dimensione dello spessore dei dispositivi

1.1.2 Second Difference of the Logarithm of the drain current Minimum method

Il secondo metodo analizzato è il *Second Difference of the Logarithm of the drain current Minimum method*, *SDLM*. Questo metodo definisce la V_{th} come la tensione V_{GS} per la quale si ha il picco minimo della derivata seconda del logaritmo naturale di I_D ripetuto alla tensione di gate ($\frac{d^2 \ln I_D}{dV_{GS}^2}$) e vale solo per alti valori di V_{DS} [2].

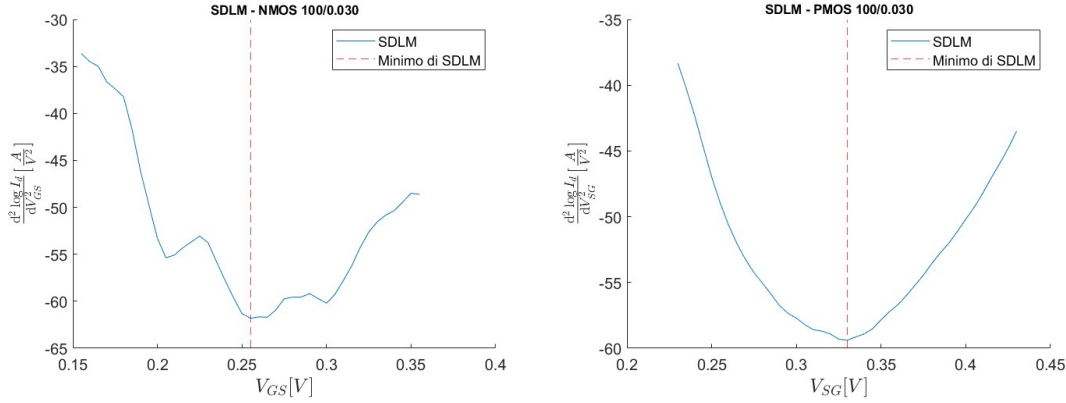


Figura 1.4: Esempio di *SDLM* usato su un dispositivo NMOS e un dispositivo PMOS di dimensioni 100-0.030 a $V_{DS} = 900mV$

Anche per questo metodo si ritrovano le problematiche presenti per il *TCM*: si deve fare il fit di una curva ottenuta come derivata seconda e inoltre la risoluzione della V_{gs} è $5mV$. Quindi, anche per questo metodo, abbiamo deciso d'interpolare la funzione ottenuta con una polinomiale e considerare il minimo di quest'ultima.

Prendendo in considerazione i dati presenti nella tabella 1.6, si nota come V_{th} assume valori molto diversi a seconda del grado della polinomiale interpolante. Nella maggior parte dei casi, le tensioni di soglia ottenute con polinomiali di grado basso (2 e 4) cambiano molto tra loro e rispetto a quelle ottenute con polinomiali di grado alto (6 e 8), mentre le misure ottenute con queste ultime sono, in genere, molto simili tra loro. Ad esempio, osservando i grafici relativi alla *SDLM* del PMOS 200-0.030 (figura 1.5), si può notare che il plot della funzione $\frac{d^2 \ln I_D}{dV_{GS}^2}$ ha un andamento che non viene interpolato in modo preciso da polinomiali di basso grado: per questo i valori minimi si discostano parecchio dai minimi ottenuti con polinomiali di grado maggiore. Risulta pertanto necessario estrarre le tensioni di soglia utilizzando una funzione polinomiale di grado 6.

Di seguito si riportano i valori delle V_{th} e delle ΔV_{th} , per i dispositivi NMOS: tabelle 1.7 e 1.9, e per i PMOS: tabelle 1.8 e 1.10. Mentre in figura 1.6 si riportano i grafici che mostrano l'andamento della variazione della tensione di soglia, in funzione della dose assorbita.

Dispositivo	$V_{th}[mV]$ con interpolante di grado:			
	2	4	6	8
100 - 0.030	332.0	322.3	323.5	327.2
100 - 0.060	423.1	416.1	411.6	411.7
200 - 0.030	303.2	298.8	296.5	296.7
200 - 0.060	413.1	404.4	404.9	405.0
200 - 0.0180	460.4	453.5	449.3	448.7
600 - 0.030	296.0	291.4	289.7	298.1
600 - 0.060	398.3	393.3	391.8	389.6
600 - 0.0180	454.7	446.7	441.4	441.3

Tabella 1.6: Confronto dei valori di V_{th} dei dispositivi PMOS ottenuti con *SDLM* con fit polinomiale di diversi gradi

Dispositivo	$V_{th}[mV]$						
	pre	5Mrad	50Mrad	100Mrad	200Mrad	600Mrad	1Grad
100 - 0.030	287.7	259.5	271.2	289.8	287.7	278.5	276.4
100 - 0.060	356.8	327.2	322.7	360.9	356.8	356.6	352.6
100 - 0.0180	404.8	381.5	369.1	422.1	404.8	422.1	418.2
200 - 0.030	279.7	262.2	269.6	277.9	279.7	267.3	268.5
200 - 0.060	355.3	325.4	313.3	357.4	355.3	351.1	348.7
200 - 0.0180	417.9	378.9	372.5	418.8	417.9	420.1	416.7
600 - 0.060	334.4	276.0	304.0	336.1	334.4	332.7	331.6
600 - 0.0180	417.1	381.5	379.6	418.4	417.1	416.2	414.3

Tabella 1.7: V_{th} dei dispositivi NMOS estratte con *SDLM*

1.1 Tensione di soglia

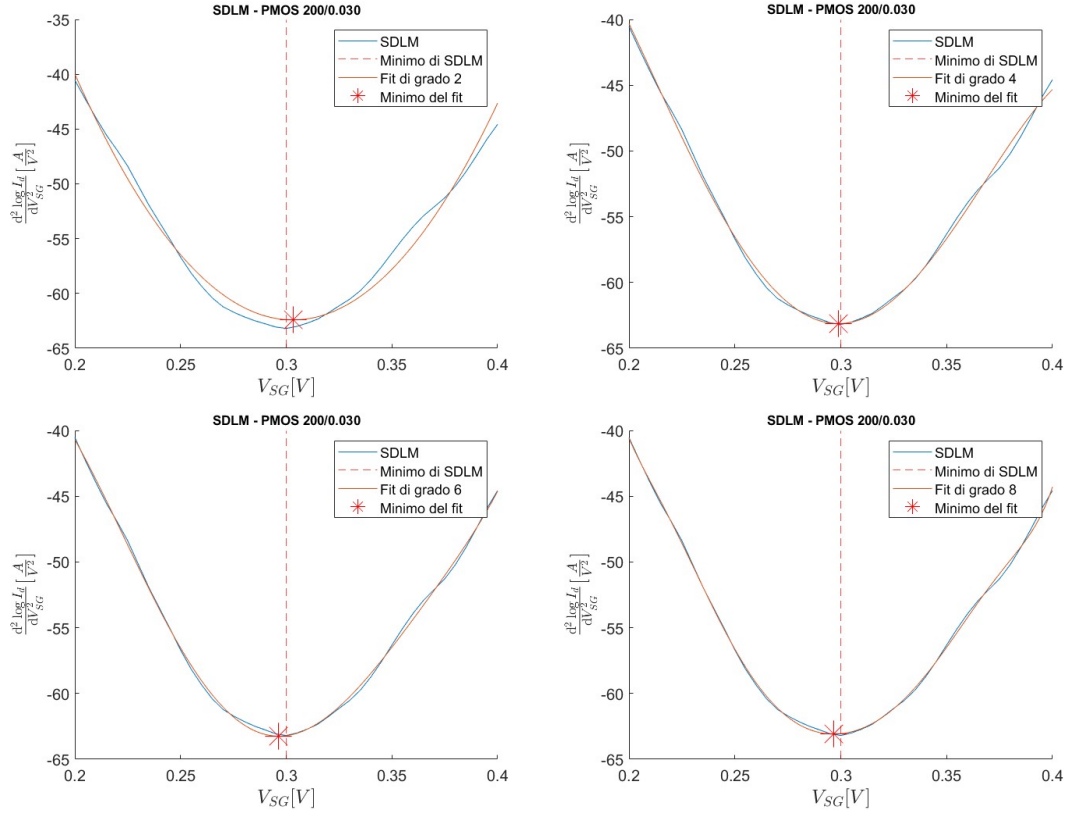


Figura 1.5: Confronto fra differenti fit (al variare del grado della funzione) della curva $\frac{d^2 \ln(I_D)}{dV_{GS}^2}$ per un dispositivo PMOS 200-0.030.

Dispositivo	$V_{th}[mV]$						
	pre	5Mrad	50Mrad	100Mrad	200Mrad	600Mrad	1Grad
100 - 0.030	323.5	329.9	327.3	330.7	329.7	343.2	355.8
100 - 0.060	411.6	409.9	412.3	415.5	416.8	428.3	435.8
200 - 0.030	296.5	292.4	301.7	299.8	304.4	320.0	323.0
200 - 0.060	404.9	403.9	405.3	407.3	413.0	422.5	430.9
200 - 0.0180	449.3	452.1	457.6	456.9	461.9	473.7	482.7
600 - 0.030	289.7	293.0	297.3	297.0	299.9	313.1	325.7
600 - 0.060	391.8	393.4	397.4	396.8	402.0	415.1	421.2
600 - 0.0180	441.4	443.4	445.1	444.6	450.9	464.5	474.2

Tabella 1.8: V_{th} dei dispositivi PMOS estratte con *SDLM*

Dispositivo	$\Delta V_{th}[mV]$					
	5Mrad	50Mrad	100Mrad	200Mrad	600Mrad	1Grad
100 - 0.030	-20.2	-8.5	10.1	8.0	-1.2	-3.3
100 - 0.060	12.1	7.6	45.8	41.7	41.5	37.5
100 - 0.0180	12.1	-0.3	52.7	35.4	52.7	48.8
200 - 0.030	-2.5	4.9	13.2	15.0	2.6	3.8
200 - 0.060	-0.6	-12.7	31.4	29.3	25.1	22.7
200 - 0.0180	7.1	0.7	47.0	46.1	48.3	44.9
600 - 0.060	-29.1	-1.1	31.0	29.3	27.6	26.5
600 - 0.0180	-3.3	-5.2	33.6	32.3	31.4	29.5

Tabella 1.9: ΔV_{th} dei dispositivi NMOS estratte con *SDLM*

Dispositivo	$\Delta V_{th}[mV]$					
	5Mrad	50Mrad	100Mrad	200Mrad	600Mrad	1Grad
100 - 0.030	6.4	3.8	7.2	6.2	19.7	32.3
100 - 0.060	-1.7	0.7	3.9	5.2	16.7	24.2
200 - 0.030	-4.1	5.2	3.3	7.9	23.5	26.5
200 - 0.060	-1.0	0.4	2.4	8.1	17.6	26.0
200 - 0.0180	2.8	8.3	7.6	12.6	24.4	33.4
600 - 0.030	3.3	7.6	7.3	10.2	23.4	36.0
600 - 0.060	1.6	5.6	5.0	10.2	23.3	29.4
600 - 0.0180	2.0	3.7	3.2	9.5	23.1	32.8

Tabella 1.10: ΔV_{th} dei dispositivi PMOS estratte con *SDLM*

1.1 Tensione di soglia

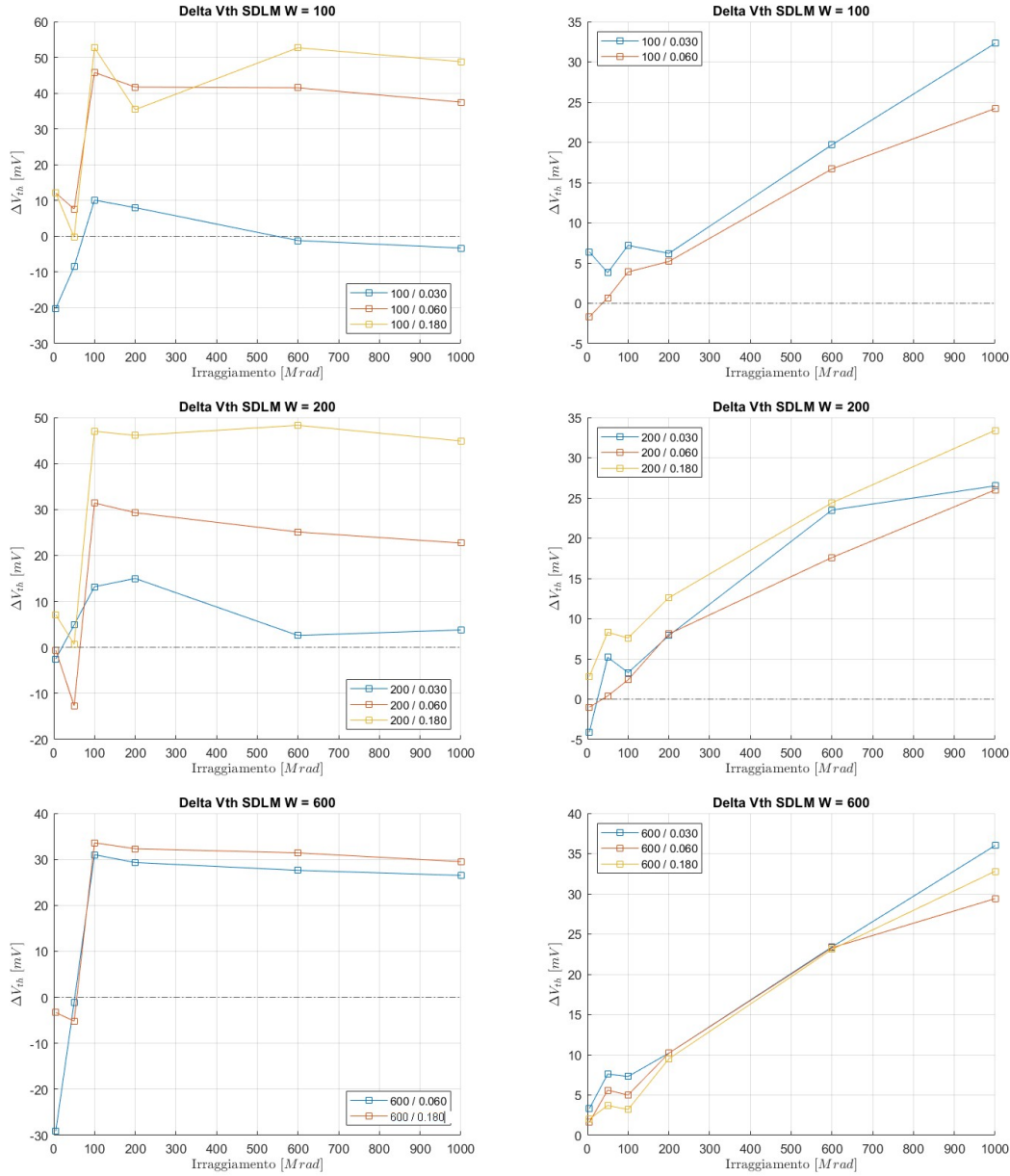


Figura 1.6: Variazioni di V_{th} dei dispositivi NMOS (a sinistra) PMOS (a destra) estratte con *SDLM* in funzione della dose assorbita. Ogni figura si riferisce a una larghezza di canale W differente. Raggruppate per dimensione dello spessore dei dispositivi

1.1.3 Extrapolation in the Linear Region method

Il terzo metodo analizzato è l'*Extrapolation in the Linear Region method*, *ELR*, con il quale si ottiene la misura della V_{th} attraverso l'analisi della caratteristica $I_D - V_{GS}$. Tale

grafico presenta un punto di flesso attorno al quale il grafico è linearizzabile. Il valore di V_{th} si ottiene sommando la metà del valore di V_{DS} al valore di V_{GS} al quale il fit lineare, ottenuto nell'intorno del punto di flesso, interseca l'asse delle ascisse[1].

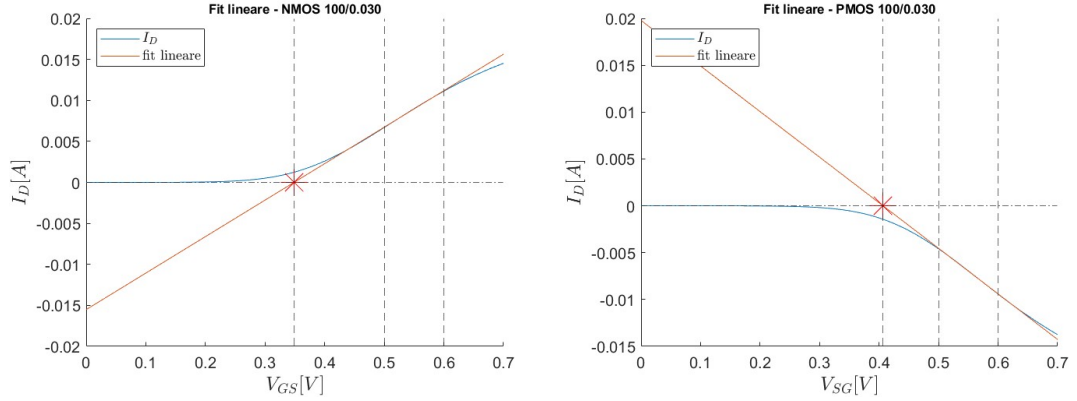


Figura 1.7: Fit lineare della caratteristica I_D - V_{GS} a $V_{DS} = 150mV$ di un NMOS e di un PMOS di dimensioni 100-0.030

Di per sé, questo metodo è meno preciso di quelli esposti precedentemente: la posizione del punto di flesso può essere incerto, perché, già a V_{GS} leggermente superiori a V_{th} , la caratteristica $I_D - V_{GS}$ può deviare dall'andamento lineare previsto a causa di errori dovuti alle resistenze parassite presenti al source e al drain dei dispositivi e alla degradazione della mobilità dei portatori di carica. Nonostante ciò, per il nostro studio questo metodo potrebbe risultare efficace, in quanto non siamo interessati al valore della tensione di soglia dei dispositivi, ma alla variazione di tale parametro all'aumentare dell'irraggiamento subito dai dispositivi. Dunque gli errori prodotti dalle resistenze parassite e dalla degradazione di mobilità divenutano irrilevanti, perché sono offset che vengono eliminati nel momento in cui si calcola la differenza tra due misure di V_{th} dello stesso dispositivo.

È infine doveroso fare una parentesi sulla regione di linearizzazione considerata per questo studio: infatti non è possibile stabilire con certezza una regione fissa in cui la funzione, ottenuta con misure sperimentali, può essere linearizzata. Il metodo da noi applicato è stato quello di analizzare tutti i possibili intervalli di linearizzazione di dimensione $100mV$ i cui estremi ricadono nell'intervallo $[300mV; 750mV]$ e scegliere quello il cui il fit approssimava meglio la funzione. All'atto pratico abbiamo considerato l'intervallo il cui fit ha il coefficiente di determinazione R^2 più alto, che è risultato essere sempre maggiore di 0.999.

Dispositivo	$V_{th}[mV]$						
	pre	5Mrad	50Mrad	100Mrad	200Mrad	600Mrad	1Grad
100 - 0.030	351.0	348.5	338.8	360.4	358.4	353.1	348.6
100 - 0.060	388.8	385.3	373.1	403.8	402.0	398.8	396.0
100 - 0.0180	465.9	461.6	449.4	482.5	481.7	482.3	481.9
200 - 0.030	336.9	334.6	324.6	346.0	344.7	341.3	338.7
200 - 0.060	382.9	379.4	366.4	396.6	395.1	393.4	391.6
200 - 0.0180	454.6	449.8	438.1	471.1	471.0	473.6	474.4
600 - 0.060	349.3	347.2	336.7	361.2	361.4	358.1	356.7
600 - 0.0180	431.8	427.5	412.4	440.6	440.1	440.8	440.4

Tabella 1.11: V_{th} dei dispositivi NMOS estratte con *ELR*

Dispositivo	$V_{th}[mV]$						
	pre	5Mrad	50Mrad	100Mrad	200Mrad	600Mrad	1Grad
100 - 0.030	405.8	406.6	408.6	410.1	416.1	429.3	436.6
100 - 0.060	452.0	452.9	454.6	456.5	462.9	475.4	484.9
200 - 0.030	376.2	377.6	379.3	380.3	386.9	397.5	404.7
200 - 0.060	434.6	435.9	437.5	439.3	445.1	458.1	467.2
200 - 0.0180	482.3	483.5	490.3	492.4	498.5	511.5	522.6
600 - 0.030	359.4	360.9	362.5	364.6	370.1	379.8	387.1
600 - 0.060	412.8	414.2	417.1	417.5	424.5	437.3	446.1
600 - 0.0180	463.2	464.4	466.4	468.9	475.2	490.8	502.9

Tabella 1.12: V_{th} dei dispositivi PMOS estratte con *ELR*

Dispositivo	$\Delta V_{th}[mV]$					
	5Mrad	50Mrad	100Mrad	200Mrad	600Mrad	1Grad
100 - 0.030	-2.5	-12.1	9.4	7.4	2.1	-2.4
100 - 0.060	-3.5	-15.8	15.0	13.1	10.0	7.2
100 - 0.0180	-4.3	-16.5	16.6	15.8	16.3	16.0
200 - 0.030	-2.3	-12.3	9.1	7.9	4.5	1.8
200 - 0.060	-3.5	-16.5	13.6	12.2	10.5	8.7
200 - 0.0180	-4.9	-16.5	16.5	16.4	19.1	19.8
600 - 0.060	-2.2	-12.7	11.8	12.0	8.8	7.4
600 - 0.0180	-4.3	-19.4	8.8	8.2	9.0	8.6

Tabella 1.13: ΔV_{th} dei dispositivi NMOS estratte con *ELR*

Dispositivo	$\Delta V_{th}[mV]$					
	5Mrad	50Mrad	100Mrad	200Mrad	600Mrad	1Grad
100 - 0.030	0.8	2.8	4.4	10.4	23.5	30.8
100 - 0.060	0.9	2.6	4.5	10.9	23.3	32.9
200 - 0.030	1.4	3.2	4.1	10.8	21.3	28.6
200 - 0.060	1.3	2.9	4.7	10.5	23.5	32.6
200 - 0.0180	1.2	8.0	10.1	16.2	29.3	40.4
600 - 0.030	1.5	3.2	5.2	10.7	20.4	27.7
600 - 0.060	1.4	4.3	4.8	11.8	24.5	33.3
600 - 0.0180	1.2	3.2	5.7	12.0	27.6	39.7

Tabella 1.14: ΔV_{th} dei dispositivi PMOS estratte con *ELR*

1.1 Tensione di soglia

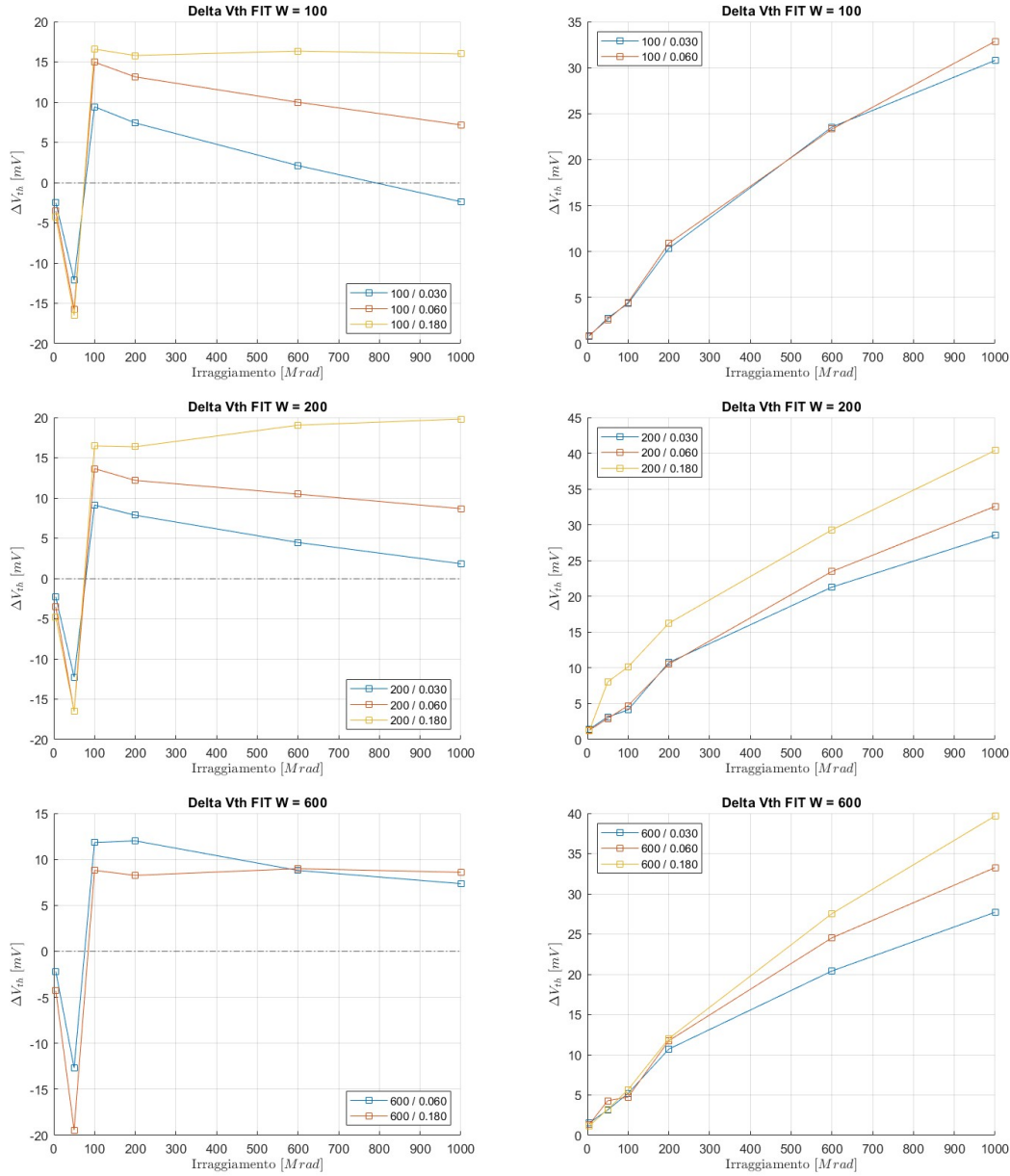


Figura 1.8: Variazioni di V_{th} dei dispositivi NMOS (a sinistra) PMOS (a destra) estratte con *ELR* in funzione della dose assorbita. Ogni figura si riferisce a una larghezza di canale W differente.

1.1.4 Ratio Method

Il *Ratio Method*, *RM* è stato sviluppato per far fronte alle problematiche dell'*ELR*: è stato infatti dimostrato che questo metodo non è influenzato dalla degradazione della mobilità dei portatori di carica né dalle correnti parassite. Questo metodo si basa sull'assunzione

che, a bassi valori di tensione di drain V_{DS} , il rapporto tra la corrente di drain I_D e la radice quadrata della transcondutanza g_m ($\frac{I_D}{g_m^{0.5}}$) in funzione della tensione di gate V_{GS} si comporti come una funzione lineare. La tensione di soglia V_{th} coincide con il valore della tensione V_{GS} a cui la funzione interseca l'asse della ascisse.

Come detto, questo metodo supera alcuni limiti dei metodi descritti in precedenza, però presenta una problematicità non indifferente: tracciando il grafico di $\frac{I_D}{g_m^{0.5}}$ in funzione di V_{GS} , questo non verifica appieno l'assunzione di linearità. Dunque non esiste un intervallo in cui il grafico è chiaramente linearizzabile e quindi la misura di V_{th} non rispecchia del tutto il valore reale della tensione di soglia, ma è comunque una buona approssimazione, soprattutto se si considera il ΔV_{th} al crescere dell'irraggiamento.

Anche in questo caso, per ottenere il fit lineare più accurato possibile è stato usato lo stesso metodo esposto per l'*ELR*.

Dispositivo	$V_{th}[mV]$						
	pre	5Mrad	50Mrad	100Mrad	200Mrad	600Mrad	1Grad
100 - 0.030	494.2	490.9	476.2	449.9	447.5	478.7	478.4
100 - 0.060	485.6	481.8	470.9	502.5	499.4	500.3	499.4
100 - 0.0180	529.4	527.8	503.8	541.0	541.9	541.4	540.9
200 - 0.030	485.2	497.4	483.1	486.8	496.7	504.1	497.3
200 - 0.060	499.8	482.9	467.2	499.6	498.9	503.1	514.1
200 - 0.0180	523.4	515.8	507.5	542.1	538.6	544.1	546.2
600 - 0.060	514.9	507.4	504.9	517.3	521.4	521.2	514.3
600 - 0.0180	539.0	537.0	525.9	546.6	546.2	545.6	546.1

Tabella 1.15: V_{th} dei dispositivi NMOS estratte con *RM*

1.1 Tensione di soglia

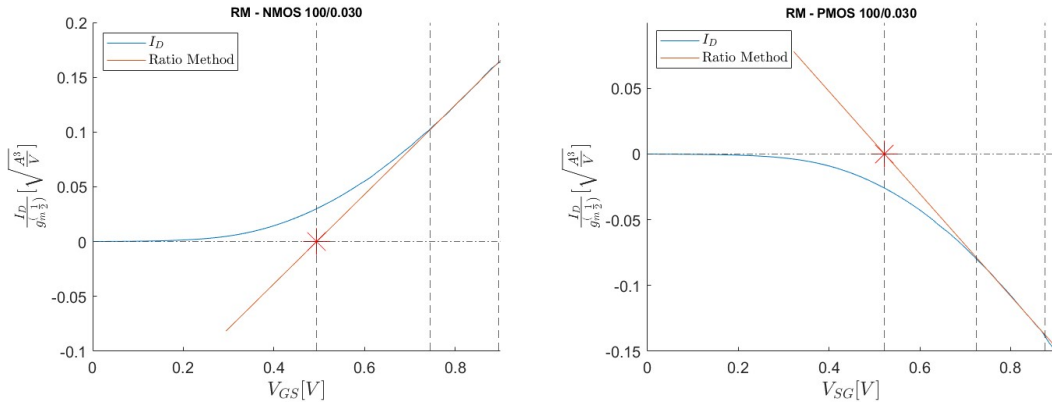


Figura 1.9: Fit lineare della caratteristica $\frac{I_D}{g_m} - V_{GS}$ a $V_{DS} = 150mV$ di un NMOS e di un PMOS di dimensioni 100-0.030

Dispositivo	$V_{th}[mV]$						
	pre	5Mrad	50Mrad	100Mrad	200Mrad	600Mrad	1Grad
100 - 0.030	522.3	529.8	530.7	532.2	533.3	544.4	547.3
100 - 0.060	543.6	543.3	541.8	545.4	548.9	528.1	541.6
200 - 0.030	525.2	520.5	527.4	542.2	544.8	551.1	554.7
200 - 0.060	547.9	540.5	549.1	550.6	555.7	563.1	568.3
200 - 0.0180	551.1	553.1	538.3	538.0	545.0	568.8	576.8
600 - 0.030	527.8	539.9	537.3	540.2	539.9	550.8	555.2
600 - 0.060	557.2	552.2	558.5	559.7	558.7	567.6	576.7
600 - 0.0180	555.2	559.3	556.9	559.4	559.7	574.3	581.3

Tabella 1.16: V_{th} dei dispositivi PMOS estratte con RM

Dispositivo	$\Delta V_{th}[mV]$					
	5Mrad	50Mrad	100Mrad	200Mrad	600Mrad	1Grad
100 - 0.030	-3.3	-18.0	-44.3	-46.7	-15.4	-15.8
100 - 0.060	-3.9	-14.7	16.8	13.8	14.7	13.8
100 - 0.0180	-1.6	-25.6	11.6	12.6	12.0	11.5
200 - 0.030	12.2	-2.1	1.7	11.5	19.0	12.1
200 - 0.060	-16.9	-32.5	-0.2	-0.9	3.3	14.3
200 - 0.0180	-7.6	-15.9	18.7	15.2	20.7	22.8
600 - 0.060	-7.5	-9.9	2.4	6.5	6.3	-0.6
600 - 0.0180	-1.9	-13.0	7.6	7.2	6.7	7.1

Tabella 1.17: ΔV_{th} dei dispositivi NMOS estratte con *RM*

Dispositivo	$\Delta V_{th}[mV]$					
	5Mrad	50Mrad	100Mrad	200Mrad	600Mrad	1Grad
100 - 0.030	7.5	8.4	9.9	11.0	22.1	25.1
100 - 0.060	-0.3	-1.8	1.8	11.0	-15.5	-2.0
200 - 0.030	-4.7	2.2	17.0	19.6	25.9	29.5
200 - 0.060	-7.5	1.1	2.6	7.7	15.2	20.3
200 - 0.0180	2.0	-12.7	-13.1	-6.1	17.8	25.7
600 - 0.030	12.1	9.5	12.4	12.1	23.0	27.5
600 - 0.060	12.1	1.3	2.5	12.1	10.4	19.5
600 - 0.0180	-4.6	1.8	4.3	4.5	19.2	26.1

Tabella 1.18: ΔV_{th} dei dispositivi PMOS estratte con *RM*

1.1 Tensione di soglia

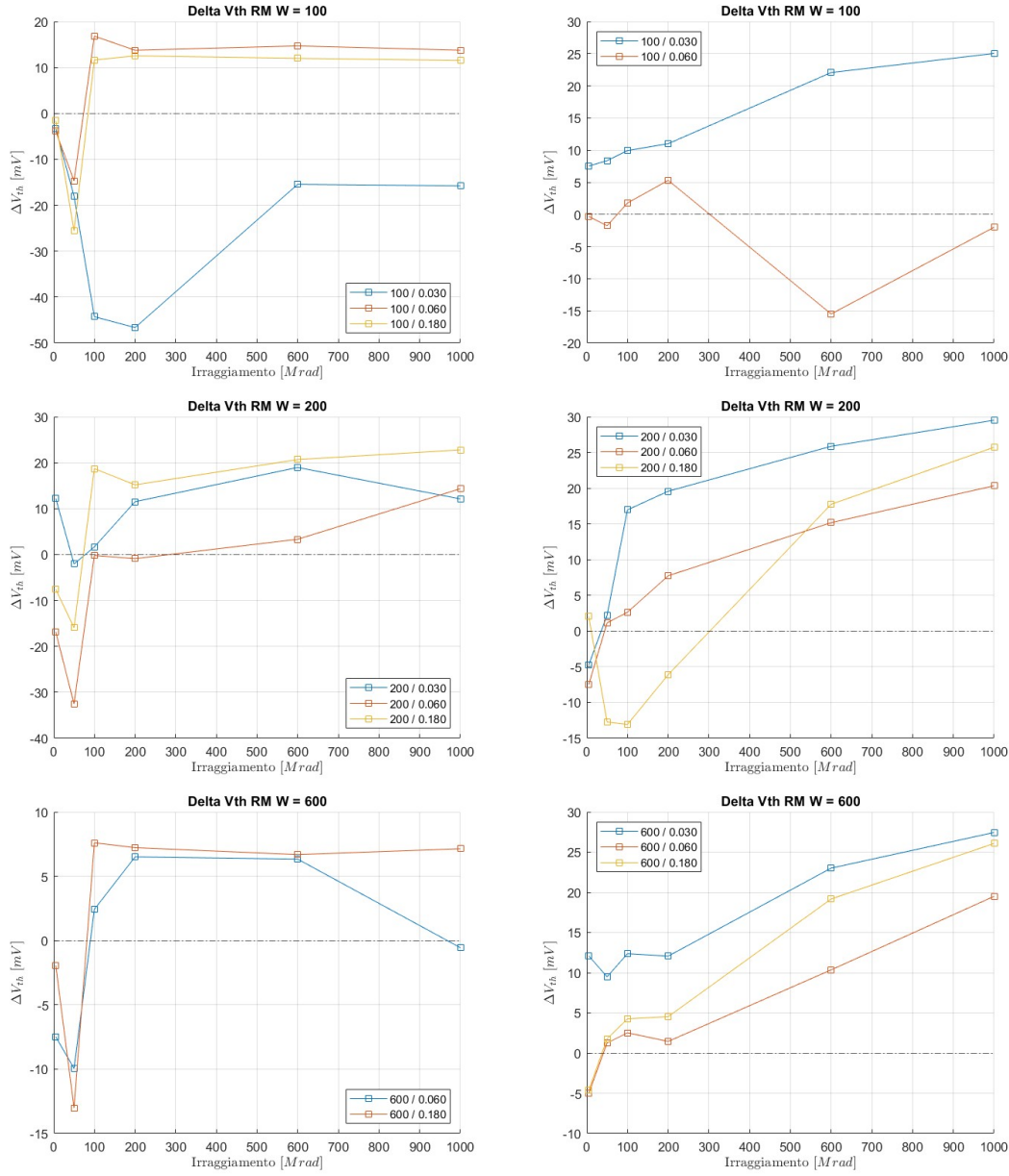


Figura 1.10: Variazioni di V_{th} dei dispositivi NMOS (a sinistra) PMOS (a destra) estratte con RM in funzione della dose assorbita. Ogni figura si riferisce a una larghezza di canale W differente.

Bibliografia

- [1] A. Ortiz-Conde, F. Garcia Sánchez, J. Liou, A. Cerdeira, M. Estrada, and Y. Yue, “A review of recent mosfet threshold voltage extraction methods,” *Microelectronics Reliability*, vol. 42, no. 4, pp. 583–596, 2002. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0026271402000276>
- [2] T. Rudenko, V. Kilchytska, M. K. M. Arshad, J.-P. Raskin, A. Nazarov, and D. Flandre, “Influence of drain voltage on mosfet threshold voltage determination by transconductance change and gm/id methods,” in *Ulis 2011 Ultimate Integration on Silicon*, 2011, pp. 1–4.